

Sol-Gel법으로 합성된 강유전성  $PbYb_{1/2}Nb_{1/2}O_3-PbTiO_3$ 의  
제조 및 전기적 특성  
(Preparation and Electrical Properties of Sol-Gel Derived Ferroelectric  
 $PbYb_{1/2}Nb_{1/2}O_3-PbTiO_3$  Thin Films)

박 순병, 주 응길  
한국과학기술원 재료공학과

강유전체 박막은 유전, 강유전, 압전, 웨전, 초전 등의 다양한 특성과 이러한 특성들의 device 응용 가능성으로 인해 박막의 합성법과 분석법, Processing-미세구조-특성의 관계에 대한 많은 연구가 진행되어 왔다. 또한 이와 같은 다양한 특성을 device에 응용하기 위해 여러 가지 기판재료에 강유전체 박막을 입힌 heterostructure에 대한 연구도 진행되고 있다. 그 예로 페롭스카이트 구조의 고유전율 재료를 고집적 DRAM에 응용하는 것이나, 강유전체 재료의 잔류분극을 이용한 비휘발성 메모리(NVFRAM)를 들 수 있다.

대표적인 강유전체 재료로  $PbZr_{1-x}Ti_xO_3$ ,  $Pb_{1-x}Lax(Zr_yTi_{1-y})O_3$  등의 Pb계 페롭스카이트 재료를 들 수 있는데, 본 연구에서는 새로운 강유전체로서 반강유전-강유전 고용체인  $Pb(Yb_{1/2}Nb_{1/2})O_3-PbTiO_3$  (이하 PYN-PT) 고용체를 박막화하고 그 특성을 조사하고자 한다. PYN-PT 고용체[1]는 고용체 형성 현상이나 제반 물리적 특성이 PZT계 고용체와 매우 유사한 특성을 가진다. 나아가 PYN-PT계의 경우 PZT계 보다 낮은 상합성 온도를 가지며 이는 박막화시 PZT계에서 문제가 되고 있는  $PbO$ 의 휘발을 억제할 수 있으리라 기대된다.  $PbO$ 의 휘발 억제는 조성 조절을 쉽게 하여 막질을 향상시키는 데 기여하며 비휘발성 메모리의 중요 특성들인 fatigue나 누설전류 특성에도 좋은 기여를 할 것으로 예상된다.

박막의 제조는 전체적으로 조성이 균일하고 양질의 막을 얻을 수 있는 Sol-Gel법을 이용하였다. Sol-Gel법은  $SiO_2$ 와 같은 간단한 재료에서부터  $PbTiO_3$ , ( $Pb,La$ ) $TiO_3$ , PZT, PLZT,  $PbMg_{1/3}Nb_{2/3}O_3-PbTiO_3$ 등의 다성분계 재료까지 거의 모든 유전체 물질에 응용할 수 있으며, 첨가물에 통해 wetting이나 점도를 조절할 수 있으므로 박막의 두께를 임의 대로 조절할 수 있다.

제조된 박막은 Pt을 sputtering시켜 상부전극을 입힌 후 유전특성 및 fatigue특성과 leakage current특성 등의 전기적 특성을 측정하였다.

[1] H. Lim, H.J. Kim and W.K. Choo, *Jpn. J. Appl. Phys.* **34**, 5449 (1995)